

POWER DISCRETES

Description

Quick reference data

$V_R = 6.2 - 200V$

$I_Z(\text{MAX}) = 7.2\text{mA} - 230\text{mA}$

$Z_Z = 4\Omega - 1500\Omega$

$I_R = 0.05\mu\text{A} - 10\mu\text{A}$

Features

- ◆ Low dynamic impedance
- ◆ Hermetically sealed.
- ◆ 1.5 Watt applications
- ◆ Low reverse leakage currents
- ◆ Small package

These products are qualified to MIL-PRF-19500/406.
They can be supplied fully released as JAN,
JANTX, JANTXV and JANS versions.

Electrical Specifications

Electrical specifications @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Device Types	V_Z Nom	V_Z Min	V_Z Max	I_Z Test Current $T_A = +25^\circ\text{C}$	Z_Z Imped.	Z_K Knee Imped.	I_Z Max DC Current	V_Z (reg) Voltage Reg.	I_{ZSM} @ $T_A = +25^\circ\text{C}$	V_R Reverse Voltage	I_R Reverse Current DC	α VZ Temp. Coeff.	I_{ZK} Test Current	I_R Reverse Current DC $T_A = 150^\circ\text{C}$
	V	V	V	mA	Ω	Ω	mA	V	A	V	μA	%/°C	mA	μA
1N4460	6.2	5.89	6.51	40	4	200	230	0.35	2.3	3.72	10	0.050	1.0	50
1N4461	6.8	6.46	7.14	37	2.5	200	210	0.30	2.1	4.08	5	0.057	1.0	20
1N4462	7.5	7.13	7.87	34	2.5	400	191	0.35	1.9	4.50	1	0.061	0.5	10
1N4463	8.2	7.79	8.61	31	3.0	400	174	0.40	1.7	4.92	0.5	0.065	0.5	5
1N4464	9.1	8.65	9.55	28	4.0	500	157	0.45	1.6	5.46	0.3	0.068	0.5	3
1N4465	10.0	9.50	10.5	25	5.0	500	143	0.50	1.4	8.0	0.3	0.071	0.25	3
1N4466	11.0	10.45	11.55	23	6.0	550	130	0.55	1.3	8.8	0.3	0.073	0.25	2
1N4467	12.0	11.40	12.6	21	7.0	550	119	0.60	1.2	9.6	0.2	0.076	0.25	2
1N4468	13.0	12.35	13.65	19	8.0	550	110	0.65	1.1	10.4	0.05	0.079	0.25	2
1N4469	15.0	14.25	15.75	17	9.0	600	95	0.75	0.95	12.0	0.05	0.082	0.25	2
1N4470	16.0	15.20	16.8	15.5	10.0	600	90	0.80	0.90	12.8	0.05	0.083	0.25	2
1N4471	18.0	17.10	18.9	14	11.0	650	79	0.83	0.79	14.4	0.05	0.085	0.25	2
1N4472	20.0	19.0	21.0	12.5	12.0	650	71	0.95	0.71	16.0	0.05	0.086	0.25	2
1N4473	22.0	20.9	23.10	11.5	14.0	650	65	1.0	0.65	17.6	0.05	0.087	0.25	2
1N4474	24.0	22.8	25.2	10.5	16.0	700	60	1.1	0.60	19.2	0.05	0.088	0.25	2
1N4475	27.0	25.7	28.3	9.5	18.0	700	53	1.3	0.53	21.6	0.05	0.090	0.25	2
1N4476	30.0	28.5	31.5	8.5	20.0	750	48	1.4	0.48	24.0	0.05	0.091	0.25	2

POWER DISCRETES
Electrical Specifications (Cont.)

Electrical specifications @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Device Types	V_Z Nom	V_Z Min	V_Z Max	I_Z Test Current $T_A = +25^\circ\text{C}$	Z_Z Imped.	Z_K Knee Imped.	I_Z Max DC Current	V_Z (reg) Voltage Reg.	I_{ZSM} @ $T_A = +25^\circ\text{C}$	V_R Reverse Voltage	I_R Reverse Current DC	α VZ Temp. Coeff.	I_{ZK} Test Current	I_R Reverse Current DC $T_A = +150^\circ\text{C}$
	V	V	V	mA	Ω	Ω	mA	V	A	V	μA	$\%/^\circ\text{C}$	mA	μA
1N4477	33	31.4	34.6	7.5	25	800	43	1.5	0.43	26.4	0.05	0.092	0.25	2
1N4478	36	34.2	37.8	7.0	27	850	40	1.7	0.4	28.8	0.05	0.093	0.25	2
1N4479	39	37.1	40.9	6.5	30	900	37	1.8	0.37	31.2	0.05	0.094	0.25	2
1N4480	43	40.9	45.1	6.0	40	950	33	1.9	0.33	34.4	0.05	0.095	0.25	2
1N4481	47	44.7	49.3	5.5	50	1000	30	2.1	0.30	37.6	0.05	0.095	0.25	2
1N4482	51	48.5	53.5	5.0	60	1100	28	2.3	0.28	40.8	0.05	0.096	0.25	2
1N4483	56	53.2	58.8	4.5	70	1300	26	2.5	0.26	44.8	0.25	0.096	0.25	10
1N4484	62	58.9	65.1	4.0	80	1500	23	2.7	0.23	49.6	0.25	0.097	0.25	10
1N4485	68	64.6	71.4	3.7	100	1700	21	3.0	0.21	54.4	0.25	0.097	0.25	10
1N4486	75	71.3	78.7	3.3	130	2000	19	3.3	0.19	60.0	0.25	0.098	0.25	10
1N4487	82	77.9	86.1	3.0	160	2500	17	3.6	0.17	65.6	0.25	0.098	0.25	10
1N4488	91	86.5	95.5	2.8	200	3000	16	4.0	0.16	72.8	0.25	0.099	0.25	10
1N4489	100	95.0	105.0	2.5	250	3100	14	4.4	0.14	80.0	0.25	0.1	0.25	10
1N4490	110	104.5	115.5	2.3	300	4000	13	5.0	0.13	88.0	0.25	0.1	0.25	10
1N4491	120	114.0	126.0	2.0	400	4500	12	5.5	0.12	96.0	0.25	0.1	0.25	10
1N4492	130	123.5	136.5	1.9	500	5000	11	6.0	0.11	104.0	0.25	0.1	0.25	10
1N4493	150	142.5	157.5	1.7	700	6000	9.5	7.0	0.095	120	0.25	0.1	0.25	10
1N4494	160	152	168	1.6	1000	6500	8.9	8.0	0.089	128	0.25	0.1	0.25	10
1N4495	180	171	189	1.4	1300	7000	7.9	10.0	0.079	144	0.25	0.1	0.25	10
1N4496	200	190	210	1.2	1500	8000	7.2	12.0	0.072	160	0.25	0.1	0.25	10

Notes:

- (1) Operating Temperature: -55°C to 175°C .
- (2) Storage Temperature: -65°C to 175°C .

POWER DISCRETES

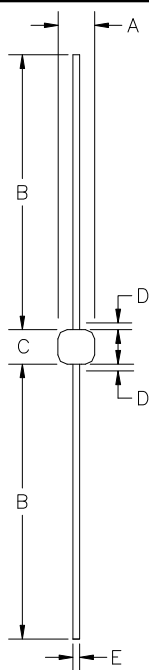
Ordering Information

Part Number	Description
1N4460	Axial leaded hermetically sealed ⁽¹⁾
THRU	
1N4496	

Note:

(1) Available in bulk or tape and reel packaging. Please consult factory for quantities.

Outline Drawing



G99

Dimensions					
DIM ^N	Inches		Millimeters		Note
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.06	0.085	1.52	2.16	-
B	0.8	1.30	20.32	33.02	-
C	0.106	0.16	2.69	4.06	-
D	-	0.05	-	1.27	1
E	0.028	0.032	0.71	0.81	-

Note:

(1) Lead diameter uncontrolled over this region.

Contact Information

Semtech Corporation
 Power Discretes Products Division
 200 Flynn Road, Camarillo, CA 93012
 Phone: (805)498-2111 FAX (805)498-3804



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331